Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0302U001507

Державний реєстраційний номер: 0101U003490

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-03-2002

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вивчення процесів іонно-плазменого осадження легованих алмазоподібних плівок. Дослідження умов низько і високотемпературних відпалів легованих плівок для утворення оптично-активних положень РЗ іонів.

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітного документа: Без звіту

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): НДВ "Оптичні та конструкційні кристали" НТК "Інститут монокристалів"

Код за ЄДРПОУ: 23756545

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (0572)32-82-30

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження процесів утворення та властивостей РЗМ легованих плівок на основі вуглецю

Назва роботи англійською:

The study of the processes of formation and properties of RE metal doped films on the basis of carbon

Реферат українською:

Вивчено процеси формування плівок карбіду кремнію в умовах осадження плазмового потоку, який генерується вакуумно-дуговим джерелом. Встановлено залежність складу плівок від енергії іонів, що осаджуються. Встановлені умови осадження нанокристалічних плівок SiC стехіометричного складу. Розроблений метод плазмового осадження плівок карбіду кремнію забезпечує нанесення плівок SiC стехіометричного складу на підкладки при кімнатній температурі зі швидкістю приблизно 20-30 нм·см-1. За даним методом вперше отримано на основі плівок карбіду кремнію нанокристалічні плівкові системи: n-SiC:Ce, n-SiC:Pr, n-SiC:Eu, n-SiC:N, n-SiC:ZnS, n-SiC:CdS, які розглядаються як перспективні плівкові матеріали для люмінесцентних, фотонних та електронних приладів.

Реферат англійською:

The process of formation of silicon carbide films deposition under conditions of plasma flux, generated by vacuum-arc source have been studied. The dependence of film composition on energy of the deposition ions has been found. Conditions of deposition of nano-crystalline SiC films of the stoichiometric composition have been found. The developed method of plasma deposition of silicon carbide films ensures application of SiC films of stoichiometric composition on the substrates at room temperature at a rate of about 20-30 nm·s-1. Using this method for the first time obtained were nanocrystalling film systems on the basis of silicon carbide films: n-SiC:Ce, n-SiC:Pr, n-SiC:Eu, n-SiC:N, n-SiC:ZnS, n-SiC:CdS, which are considered as promising film materials for luminescence, photon and electron devices.5635

Індекс УДК: 539.12;537.8, 539.216:546.26-162

Коди тематичних рубрик: 29.05.01

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Пузіков В.М.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Пузіков В.М.

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

